



Vážený pan

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.

děkan FSI VUT v Brně

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Technická 2896/2, 616 69 Brno

dekan@fme.vutbr.cz**Váš dopis značky / ze dne**

N/A

Naše značka

1-20160902

Vyřizuje / linka

Lorenc, 604 975 564

Rožnov pod Radhoštěm

8. 9. 2016

Věc: Vyjádření uznání za vynikající výsledky studentky FSI VUT

Vážený pane děkane,

Považujeme za nutné vyjádřit naše uznání za vynikající výsledky studentky Vaši fakulty Violy Křížákové, kterých dosáhla během své dvouměsíční stáže v naší společnosti.

Viola Křížáková (4. ročník studijního oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie) s vysokou mírou samostatnosti naplnila náročné cíle zadlého úkolu „Multivrstevnaté struktury se zvýšenou stabilitou getrační schopnosti“. Na základě instrukcí vedoucího práce Ing. Davida Lysáčka, Ph.D. zpracovala danou problematiku na teoretické úrovni s následnou praktickou realizací náročných procesních testů.

Celkový rozsah a kvalita provedených prací výrazně přesáhly naše očekávání. Viola Křížáková shrnutí svých výsledků úspěšně prezentovala managementu společnosti, pracovníkům výzkumu a vývoje, a technologům operací výroby polovodičových materiálů a součástek. Hodinové přednášky se dne 2. 9. 2016 zúčastnilo celkem 25 pracovníků s odpovídající hlubokou technickou diskusí, při které studentka jednoznačně prokázala úroveň svých odborných znalostí. Vynikajícím závěrem stáže pak bylo technické schválení kvalifikace nového technologického procesu „Kvalifikace nové technologie extrinsické getrace – multivrstevnaté struktury“ dne 1. 9. 2016. Prezentaci nového procesu před změnovou komisi naší společnosti provedla Viola Křížáková jako realizátorka změny, a to včetně splnění specifických požadavků vyžadovaných pro nové procesy (jako je např. analýza rizik, analýza propustnosti a nákladů výroby, plán implementace).

Práce studentky z odborného hlediska také naplňuje dílčí cíle projektů „TE01020233 Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie (AMISPEC)“ a „TH01010419 Výzkum a vývoj nových technologií výroby bipolárního tranzistoru s izolovaným hradlem“ řešených ve spolupráci se skupinou prof. RNDr. Tomáše Šikoly, CSc.

Celkově považujeme spolupráci s Violou Křížákovou za naplnění našich představ o studentech VŠ z hlediska potenciálu pro uplatnění v naší společnosti a také z pohledu účelného zapojení studentů do společných výzkumně-vývojových projektů. Věříme, že naše přednášky pro studenty FSI VUT „Fyzikální principy technologie výroby polovodičů“ a výzkumná spolupráce na společných projektech LDDA (Laboratoře pro diagnostiku defektů a



analýzy povrchů křemíku) a třech projektech řešených s podporou TAČR v rámci programů „EPSILON“ a „Center kompetence“ přispějí k dalším úspěchům studentů VUT a ke zvýšení možností jejich účelného uplatnění v praxi.

Se srdečným pozdravem

Ing. David Lysáček, Ph.D.
Inženýr nových produktů
david.lysacek@onsemi.com

RNDr. Petr Pánek, Ph.D.
Ředitel výrobní linky křemíkových desek
petr.panek@onsemi.com

Mgr. Michal Lorenc
Vedoucí projektů výzkumu a vývoje
michal.lorenc@onsemi.com

Na vědomí
Prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (sikola@fme.vutbr.cz)
Bc. Viola Křížáková (krizakova.viola@gmail.com)

Nadnárodní korporace ON Semiconductor (NASDAQ: ON) se sídlem v Phoenixu (USA) je předním světovým výrobcem širokého portfolia polovodičových součástek. V roce 2015 bylo prodáno více než 49 miliard polovodičových součástek v oblasti řízení napájení, zpracování signálu, logických, diskrétních, analogových a digitálních obvodů pro segmenty výroby automobilů, průmyslových, leteckých, kosmických, vojenských a lékařských aplikací, komunikačních technologií, spotřební elektroniky a výpočetní techniky. Celosvětově zaměstnává korporace přes 24 tisíc pracovníků s ročními tržbami na úrovni 3,5 miliardy dolarů. V České republice zaměstná korporace 1,5 tisíce kvalifikovaných pracovníků v:

- ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC (www.onsemi.cz) v Rožnově pod Radhoštěm - se zaměřením na výzkum, vývoj a výrobu polovodičových substrátů, integrovaných obvodů a diskrétních polovodičových součástek,
- SCG Czech Design Center v Rožnově pod Radhoštěm a ON Design Czech v Brně - středisek pro návrh integrovaných obvodů.